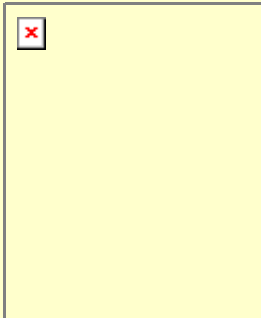


## 本期封面



2001年9期

栏目:

DOI:

论文题目: A1203陶瓷的氢致滞后断裂

作者姓名: 史博 宿彦京 乔利杰 褚武扬

工作单位: 北京科技大学材料物理系, 北京100083

通信作者: 史博

通信作者Email: [shibo@sina.com](mailto:shibo@sina.com)

文章摘要: A1203封装陶瓷在恒载荷下动态充氢能发生氢致滞后断裂, 其门槛应力强度因子为 $K_{IH}=0.71K_{Ic}$  ( $i=20 \text{ mA/cm}^2$ ) 及 $0.45K_{Ic}$  ( $i=400 \text{ mA/cm}^2$ ). 氢致开裂区全是沿晶断口, 而空拉断口则是沿晶和解理构成的混合断口

关键词: A1203, 封装器件, 氢致开裂

分类号: TB32, TN405

关闭